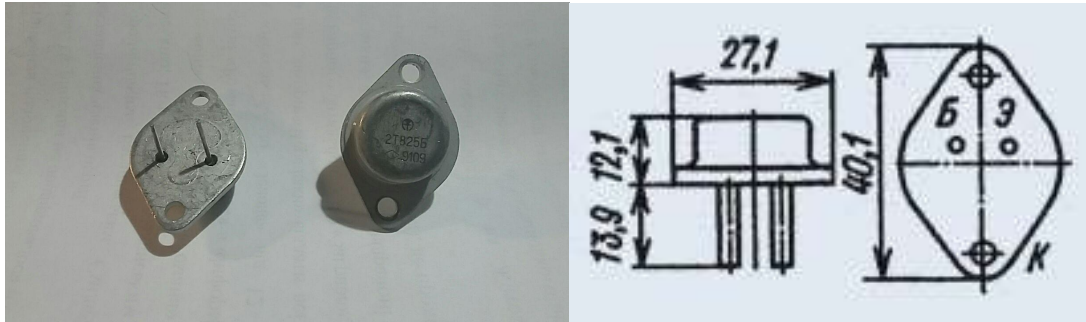


Транзистор 2Т825Б



Основные технические характеристики транзистора 2Т825Б:

- Структура транзистора: р-п-р;
- $P_{к\text{ т max}}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 125 Вт;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 4 МГц;
- $U_{эб\text{о max}}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В;
- $I_{к\text{ max}}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 20 А;
- $I_{к\text{ и max}}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 30 А;
- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 750...18000;
- S_k - Емкость коллекторного перехода: не более 600 пФ;
- $R_{кэ\text{ нас}}$ - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,4 Ом

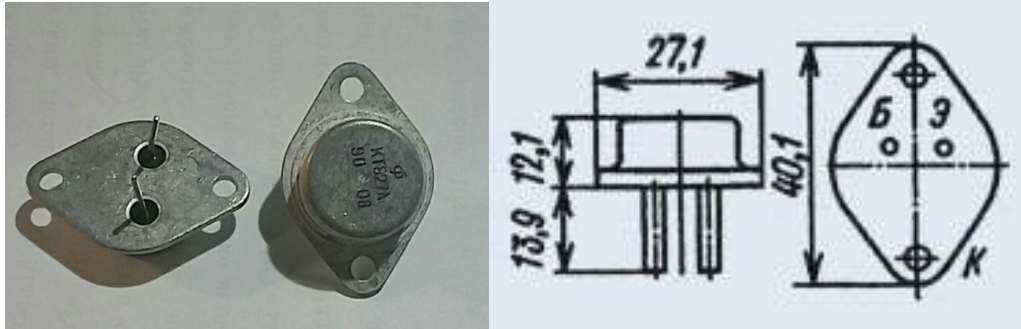
Масса транзистора:

- в металлическом корпусе не более 20 г,
- кристалла не более 0,025 г.

Тип корпуса: КТ-9 (ТО-3).

Технические условия: аА0.339.054 ТУ.

Транзистор 2Т827А



Основные технические характеристики транзистора 2Т827А:

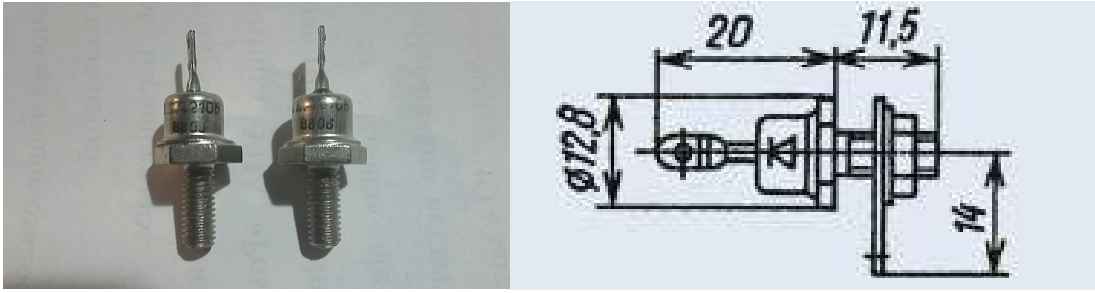
- Структура транзистора: n-p-n;
- $P_{к\text{т max}}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 125 Вт;
- $f_{гр}$ - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 4 МГц;
- $U_{кэг max}$ - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 100 В (1кОм);
- $U_{эбo max}$ - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 5 В;
- $I_{к max}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 20 А;
- $I_{к и max}$ - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 40 А;
- $I_{кэг}$ - Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база-эмиттер: 3 мА (100В);
- $h_{21э}$ - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 750... 18000;
- $C_{к}$ - Емкость коллекторного перехода: не более 400 пФ;
- $R_{кэ нас}$ - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,2 Ом

Масса транзистора в металлическом корпусе не более 20 г, кристалла не более 0,01 г.

Тип корпуса: КТ-9 (ТО-3).

Технические условия: аА0.339.139 ТУ.

Диод КД210Б



Масса диода с комплектующими деталями не более 8,32 г.

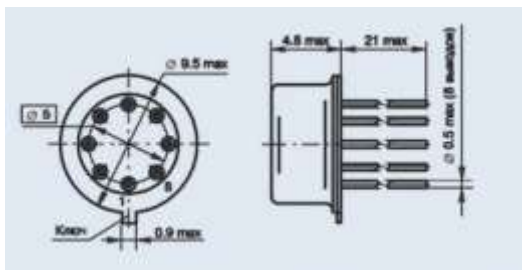
Тип корпуса: КД-11.

Технические условия: УЖ0.336.088 ТУ.

Основные технические характеристики диода КД210Б:

- $U_{обр\ max}$ - Максимальное постоянное обратное напряжение: 800 В;
- $I_{пр\ max}$ - Максимальный прямой ток: 10 А;
- f_d - Рабочая частота диода: 1 кГц;
- $U_{пр}$ - Постоянное прямое напряжение: не более 2 В при $I_{пр}$ 10 А;
- $I_{обр}$ - Постоянный обратный ток: не более 4,5 мА при $U_{обр}$ 800 В

Микросхема К140УД7



Микросхемы К140УД7 представляют собой операционные усилители средней точности, с внутренней частотной коррекцией и защитой входа и выхода от короткого замыкания и установкой нуля (балансировкой) с помощью одного резистора.

Содержат 35 интегральных элементов.

Корпус типа 301.8-2, масса не более 1,5 г.

Напряжение питания: $\pm 15\text{ В} \pm 10\%$.

Ток потребления: не более 3,6 мА.

Рабочая температура: $-60...+125^\circ\text{C}$.

Минимальный срок сохраняемости микросхем при их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.